

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 7 月 30 日 (2009.7.30)

【公開番号】特開 2008-4893 (P2008-4893A)

【公開日】平成 20 年 1 月 10 日 (2008.1.10)

【年通号数】公開・登録公報 2008-001

【出願番号】特願 2006-175611 (P2006-175611)

【国際特許分類】

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 27/12 (2006.01)

G 0 6 K 19/077 (2006.01)

G 0 6 K 19/07 (2006.01)

B 4 2 D 15/10 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/78 6 1 9 A

H 0 1 L 29/78 6 1 3 Z

H 0 1 L 29/78 6 2 7 D

H 0 1 L 27/12 B

G 0 6 K 19/00 K

G 0 6 K 19/00 H

B 4 2 D 15/10 5 2 1

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 6 月 12 日 (2009.6.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に設けられた素子形成層と、  
前記素子形成層上に設けられた記憶素子部と、  
前記素子形成層上に設けられたアンテナとして機能する導電層と、  
前記素子形成層、前記記憶素子部および前記導電層上に設けられた樹脂層と、を有し、  
前記導電層の膜厚に対する、前記素子形成層および前記記憶素子部上の前記樹脂層の膜  
厚の膜厚比は、1 . 2 以上であり、  
前記導電層の膜厚に対する、前記導電層上の前記樹脂層の膜厚の膜厚比は、0 . 2 以上  
であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記樹脂層は、エポキシ樹脂からなることを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記基板は、膜厚が  $2\ \mu\text{m}$  以上  $20\ \mu\text{m}$  以下であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか 1 項において、

前記基板は、ポリプロピレンからなるフィルム、ポリエステルからなるフィルム、ビニルからなるフィルム、ポリフッ化ビニルからなるフィルム、塩化ビニルからなるフィルム、繊維質な材料からなる紙、基材フィルム（ポリエステル、ポリアミド、無機蒸着フィルム、紙類等）と接着性合成樹脂フィルム（アクリル系合成樹脂、エポキシ系合成樹脂等）との積層フィルムの、いずれかであることを特徴とする半導体装置。